

产品特性

- TSSOP16, QFN 16 脚封装
- I/O 电压: 1.8v——5.5v
- Core 电压: 1.8v——3.6v
- 最大 1MHZ 的连续数据输出率
- 温度范围-40°C——125°C
- 四线 SPI 接口
- 脉冲发生器
- 时钟校准单元
- 精确停止脉冲使能窗口
- 上升沿/下降沿单独触发或者上升沿和下降沿同时触发

产品应用

- 便携式电池供电仪器
- 数字增益和偏移调整
- 可编程电压源和电流源
- 可编程衰减器
- 模数转换器参考电压源
- 传感器参考电压源
- 范围检测器

产品概述

CBM128S085/CBM108S085 为一款高精度高集成度的数模转换器芯片,单芯片集成了 8 通道 12/10 位带输出缓冲驱动的数字输出数模转换器。芯片采用较小的 16 管脚 TSSOP 封装;正常工作电源电压范围为 2.7V~5.5V;输出缓冲驱动能够保证输出电压为轨到轨,进而确保最大的电压输出范围;功耗很低,在不带负载的情况下,整体消耗的电流仅为 540uA@3V, 600uA@5V;采用三线串行接口,最大时钟可达 40MHz,允许很灵活的配置,兼容目前常见的 SPI™, QSPI, MICROWIRE 和 DSP 等接口标准;支持菊花链工作模式,采用单个接口可以同时控制多个芯片,保证多个芯片在同一时刻进行状态更新。

CBM128S085/CBM108S085 有两个外部参考电压输入,其中一个提供给通道 A 至 D 使用,另外一个提供给通道 E 至 H 使用。每个参考电压均可以进行单独配置,允许输入范围为 0.5V~V_A,进而确保芯片提供尽可能宽的动态输出范围。串行接口控制的数字输入端 16 个移位寄存器能方便控制芯片的工作模式,包括休眠输出状态和输出更新状态等;所有通道都可以单独进行状态更新或者统一进行状态更新。

CBM128S085/CBM108S085 的最大特点就是同时支持上电复位和断电复位两种复位方式;上电复位电路保证在电源电压上升至有效电压时,数模转换器的输出为 0V,并一直保持该状态直到接收到新的状态更新命令;当芯片电源电压下降至低于 2.7V 时,断电复位电路对芯片进行复位,使得数模转换器输出为 0V,避免数模转换器非 0V 输出电压对系统电路造成影响。芯片多通道可以灵活配置,允许各通道单独工作,并支持三种不同的输出阻抗休眠模式;当所有的数模转换器进入休眠模式,芯片处于 uW 级功耗。芯片的低功耗特性使其非常适合应用于便携式设备中。

目 录

产品特性.....	1
产品应用.....	1
产品概述.....	1
目录.....	2
修订日志.....	3
功能框图.....	4
绝对最大额定值.....	5
推荐工作范围.....	5
静态特性.....	6
动态特性.....	8
引脚配置图.....	9
引脚描述.....	10
典型性能描述.....	9
功能说明.....	16
串行接口.....	18
封装尺寸及结构.....	22
TSSOP-16.....	22
QFN-16.....	23
包装/订购信息.....	24

修订日志

版本	修订日期	变更内容	变更原因	制作	审核	备注
V1.0						初始版本
V1.1	2025.8.4	更新产品引脚标注错误	错误更新	WW	LYL	

功能框图

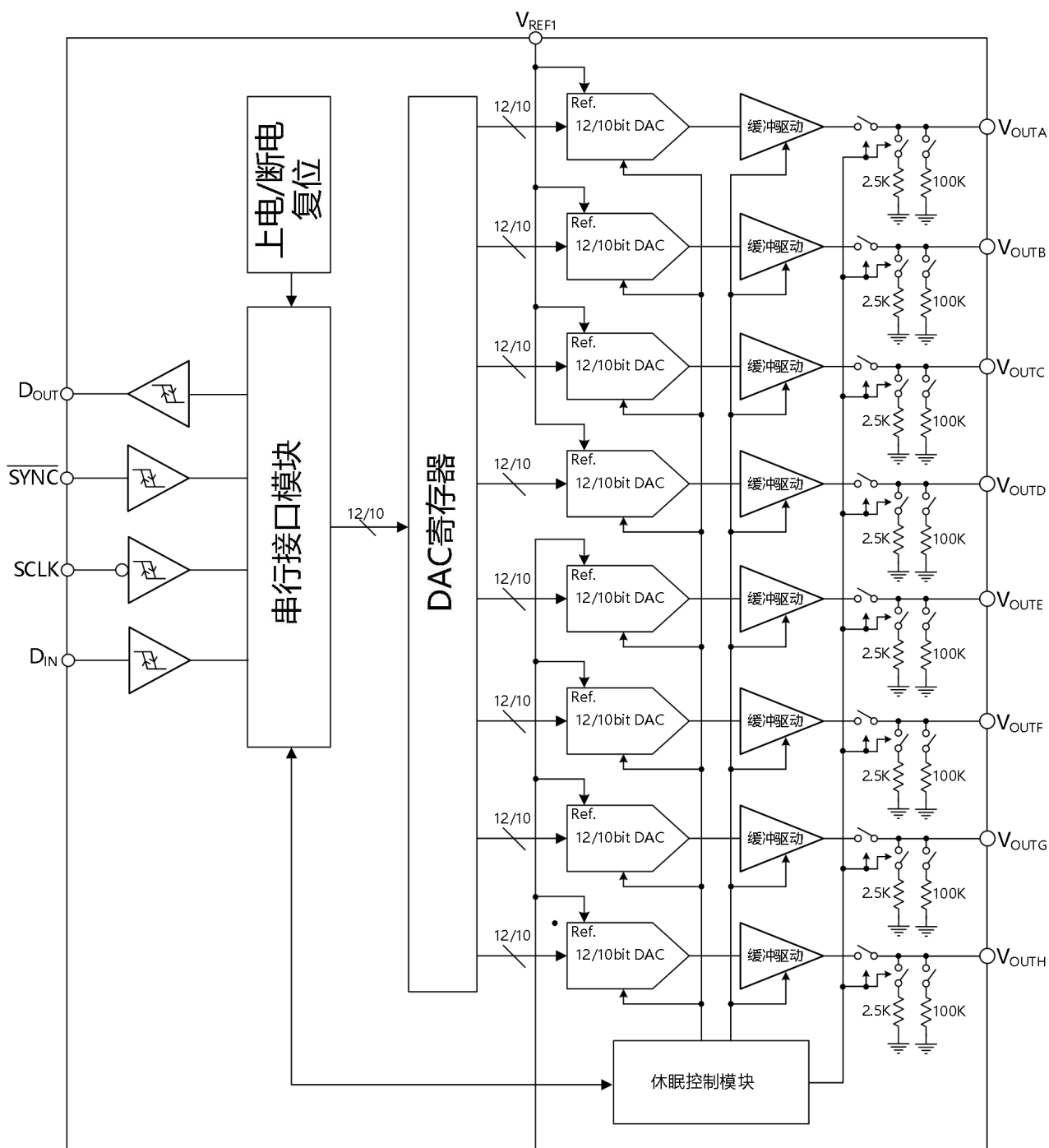


图 1 功能结构框图

绝对最大额定值

表 1 (T_A=25°C, 特殊说明除外。)

参 数 ¹	符号	数值
电源电压相对地	V _{Aabs}	-0.3V to +7V
数字输入电压相对地	V _{Digabs}	-0.3V to +0.3V
参考输入电压相对地	V _{refabs}	-0.3V to +0.3V
A ~ H 相对地	V _{outabs}	-0.3V to +0.3V
温度范围		
存储温度范围	T _S	-65°C to +150°C
结温	T _{Jmax}	150°C
ESD特性		
人体模型		5000V
机器模型		300V
充电设备模型		1000V

1. 超出最大绝对额定值的操作可对芯片造成不可恢复的损害, 而长期暴露在最大绝对额定值下会影响芯片的可靠性。

推荐工作范围

表 2

参数	符号	范围		单位
		最小值	最大值	
电源电压	V _A	2.7	5.5	V
工作电流 ¹	I _A	300	700	uA
环境温度	T _A	-40	125	°C
参考电压	V _{REF1,2}	0.5	V _A	V
输出负载	C _{Load}	0	1500	pF
SCLK 时钟频率	F _{SCLK}	\	40	MHz

1. DAC 输出空载情况下

静态特性

表 3 ($V_A=2.7V$ to $5.5V$; $V_{REF1,2}=V_A$; $C_L=200pF$ 到地; $T_A=25^{\circ}C$; 特殊说明除外。)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性 ^{1,2}						
CBM128S085						
分辨率	Res_N			12		Bits
积分非线性	INL			± 2		LSB
差分非线性	DNL	保证单调性		± 0.2		LSB
CBM108S085						
分辨率	Res_N			10		Bits
积分非线性	INL			± 0.5		LSB
差分非线性	DNL	保证单调性		± 0.05		LSB
零码误差	ZE	$I_{OUT} = 0$		+5	+15	mv(max)
满幅误差	FSE	$I_{OUT} = 0$		-0.1		% FSR(max)
增益误差	GE			-0.2		% FSR(max)
零码误差温漂	ZCED			-20		$\mu V/^{\circ}C$
增益误差温漂	TC GE			-1.0		ppm/ $^{\circ}C$
参考电压输入特性						
$F_{1,2}$ 输入范围			0.5		V_A	V
$F_{1,2}$ 输入阻抗				45		K Ω
输出特性						
最小输出电压				0		V
最大输出电压				$V_{REF1,2}$		V
直流输出阻抗	Z_{OUT}			0.5		Ω
零码输出	ZCO	$V_A = 3V, I_{OUT} = 200\mu A$		10		mv
		$V_A = 3V, I_{OUT} = 1mA$		45		mv
		$V_A = 5V, I_{OUT} = 200\mu A$		8		mv
		$V_A = 5V, I_{OUT} = 1mA$		34		mv
满幅输出	FSO	$V_A = 3V, I_{OUT} = 200\mu A$		2.984		V
		$V_A = 3V, I_{OUT} = 1mA$		2.933		V
		$V_A = 5V, I_{OUT} = 200\mu A$		4.987		V
		$V_A = 5V, I_{OUT} = 1mA$		4.955		V
输出短路电流 (Source)	IOS	$V_A = 3V, V_{OUT} = 0V$, Input Code = FFFh		-20		mA
		$V_A = 5V, V_{OUT} = 0V$, Input Code = FFFh		-20		mA

输出短路电流 (Sink)	I _{OS}	V _A = 3V, V _{OUT} = 3V, Input Code = 000h		20		mA
		V _A = 5V, V _{OUT} = 5V, Input Code = 000h		20		mA
最大负载电容	C _L	R _L = ∞		1500		pF
		R _L = 2kΩ		1500		pF
逻辑输入特性 3						
输入低电平		V _A =3V			0.6	V
		V _A =5V			0.8	V
输入高电平		V _A =3V	2.1			V
		V _A =5V	2.4			V
输入电容				3		pF
功耗特性						
电源电压	V _A		2.7		5.5	V
电源静态电流	I _{ST}	F _{SCLK} =0, 输出空载 V _A = 2.7V ~ 3.6V, 输入码为 0x800		540		uA
		F _{SCLK} =0, 输出空载 V _A =4.5V ~ 5.5V, 输入码为 0x800		600		uA
参考电压电流		V _A = 2.7V ~ 3.6V, 输入码为 0x800		73		uA
		V _A =4.5V ~ 5.5V, 输入码为 0x800		110		uA
休眠电流 4			F _{SCLK} =0, Sync=V _A , D _{IN} =0V, DAC 处于休眠模式		10	

- 1.静态特性测试时，DAC 输出无负载
- 2.线性特性测试时，输入码范围：CBM128S085(Code 48 to Code 4047), CBM108S085(Code 12 to Code 1011)
- 3.设计值非实际测试值
- 4.休眠模式下，芯片的断电复位电路仍然工作，消耗约 10 μA 电流

动态特性

表 3 ($V_A=2.7V$ to $5.5V$; $V_{REF1,2}=V_A$; $C_L=200pF$ 到地; $T_a=25^\circ C$; 特殊说明除外。)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
SCLK 频率	F_{SCLK}				40	MHz
输出电压建立时间 ¹	T_S	$R_L=2K\Omega$, $C_L=200pF$, 数字码 0x400 到 0xC00		6	8.5	μS
输出压摆率	SR			1		V/ μS
毛刺	GI	数字码 0x7FF 到 0x800		40		nV-sec
数字馈通 ¹	DF			0.5		nV-sec
数字串扰 ¹	DC			0.5		nV-sec
多通道串扰 ¹	CROSS			1		nV-sec
输出带宽	MBW	$V_{REF1,2} = 2.5V \pm 2V_{pp}$		350		KHz
总谐波失真与噪声 ¹	THD+N	$V_{REF1,2} = 2.5V \pm 0.5V_{pp}$ $100Hz < F_{IN} < 20kHz$		-80		dB
输出噪声频谱密度 ¹	ONSD	数字码 0x800, 10kHz		80		nV/sqrt(Hz)
输出噪声 ¹	ON	BW = 30kHz		14		μV
唤醒时间	T_{WU}	$V_A=3V$		5		μS
		$V_A=5V$		3		μS
SCLK 最小周期	$1/F_{SCLK}$			25	33	nS
SCLK 最小高电平时间	T_{CH}			7	10	nS
SCLK 最小低电平时间	T_{CL}			7	10	nS
YNC 最小建立时间	T_{SS}			3	10	nS
DATA 最小建立时间	T_{DS}			1	2.5	nS
DATA 最小保持时间	T_{DH}			1	2.5	nS
YNC 最小保持时间	T_{SH}			0	3	nS
YNC 最小高电平时间	T_{SYNC}			5	15	nS

1. 设计值非实际测试值

引脚配置图

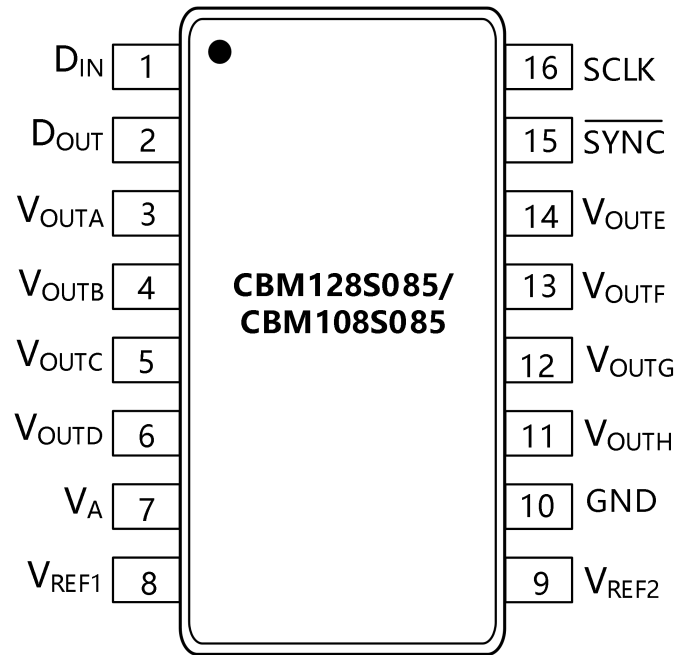


图 2. TSSOP16 管脚配置

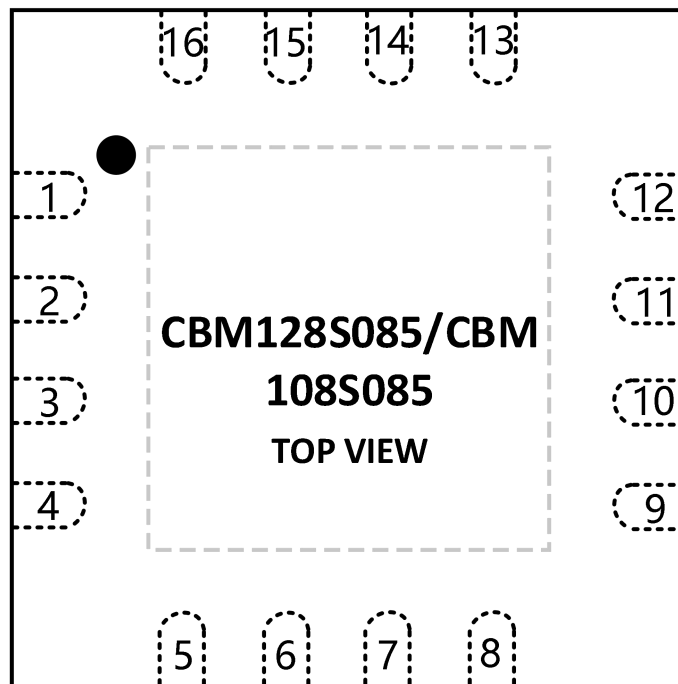


图 3. QFN16 管脚配置

引脚描述

表 5.

管脚名	管脚		类型	描述
	TSSOP 编号.	QFN编 号.		
D _{IN}	1	15	数字输入	串行数据输入. 在帧同步信号变高前, 16 个时钟信号下降沿将数据输入至 16 位移位寄存器.
D _{OUT}	2	16	数字输出	串行数据输出. 该数字输出在菊花链模式时使用, 用于连接另一块 CBM128S085 芯片的输入. 出现 16 个时钟周期前, 帧同步信号变高, 该数字输出无效.
GND	10	8	地	整个芯片的地电位参考电压.
SCLK	16	14	数字输入	串行时钟输入. 在该时钟的下降沿, 数字信号被输入至移位寄存器. 时钟最高工作频率为 40MHz.
SYNC	15	13	数字输入	帧同步输入信号. 当该信号为低时, 数字信号在时钟下降沿写入至输入移位寄存器. 时钟信号出现 16 个下降沿后, 该信号的上升沿使 DAC 输出更新. 若该信号在 15 个上升沿前变高, 该信号的上升沿视为中断信号, DAC 的输出将忽略输入序列.
V _A	7	5	电源	电源输入. 电源输入范围为 2.7V~5.5V, 工作时接去耦合电容到地.
V _{OUTA}	3	1	模拟输出	A 通道模拟输出电压.
V _{OUTB}	4	2	模拟输出	B 通道模拟输出电压.
V _{OUTC}	5	3	模拟输出	C 通道模拟输出电压.
V _{OUTD}	6	4	模拟输出	D 通道模拟输出电压.
V _{OUTE}	14	12	模拟输出	E 通道模拟输出电压.
V _{OUTF}	13	11	模拟输出	F 通道模拟输出电压.
V _{OUTG}	12	10	模拟输出	G 通道模拟输出电压.
V _{OUTH}	11	9	模拟输出	H 通道模拟输出电压.
V _{REF1}	8	6	模拟输入	A、B、C、D 通道共享参考电压. 电压范围为 0.5V~V _A , 工作时接去耦合电容到地.
V _{REF2}	9	7	模拟输入	E、F、G、H 通道共享参考电压. 电压范围为 0.5V~V _A , 工作时接去耦合电容到地.

PAD(仅 QFN 封 装)	--	17	地	暴露的管芯连接焊盘可以连接到地或保持悬空。将焊盘焊接到PCB可提供最佳的热性能，并增强回流期间的封装自对准。
----------------------	----	----	---	--

典型性能描述

$V_A = V_{REF} = 5V$, $T_A = 25^\circ C$, 特殊说明除外

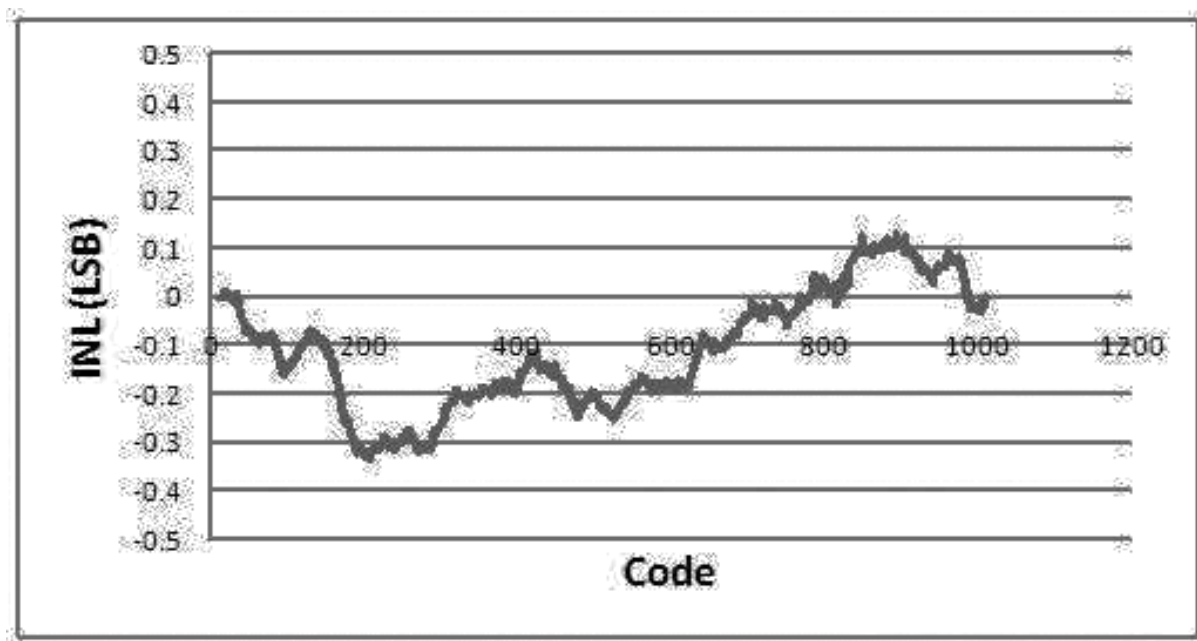


图 4. CBM108S085 典型 INL

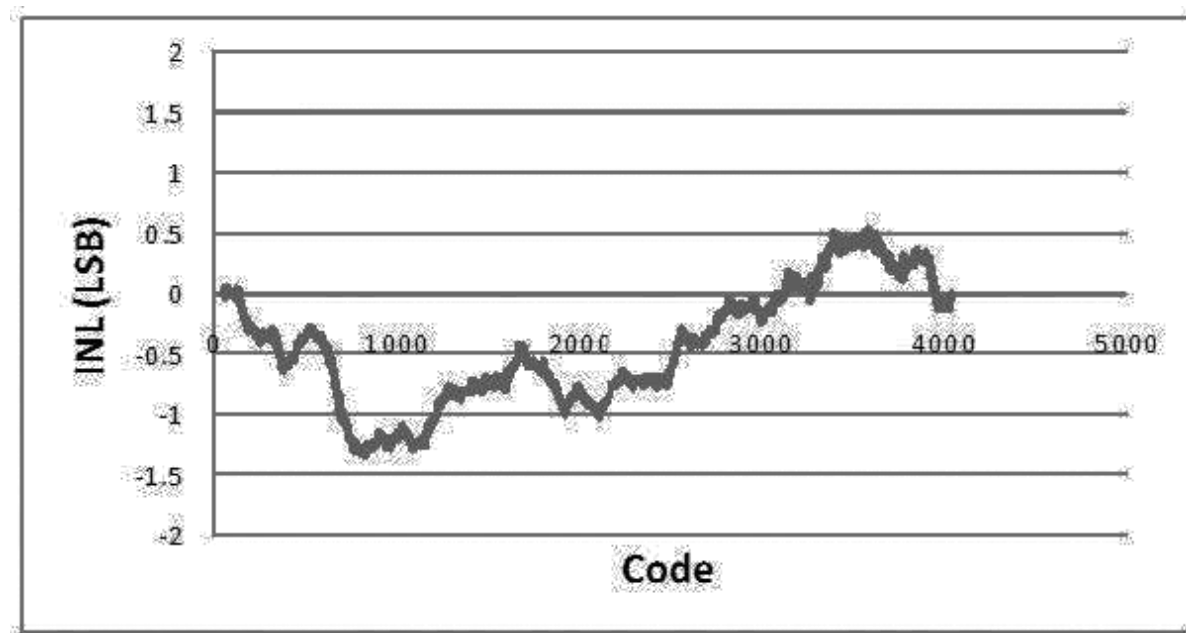


图 5. CBM128S085 典型 INL

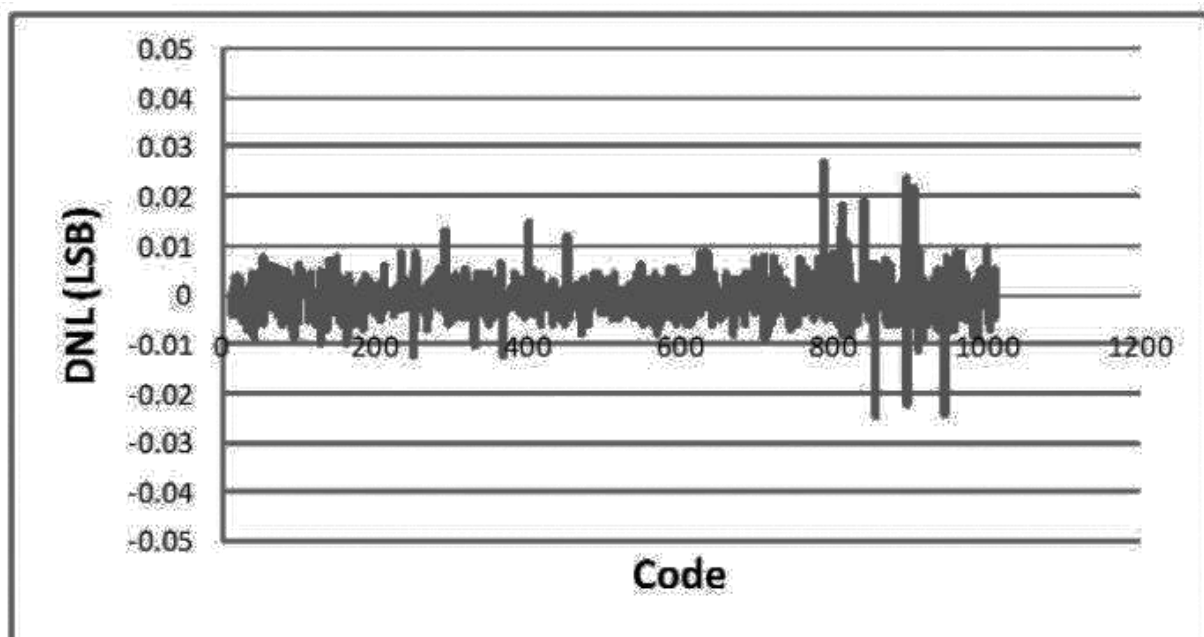


图 6. CBM108S085 典型 DNL

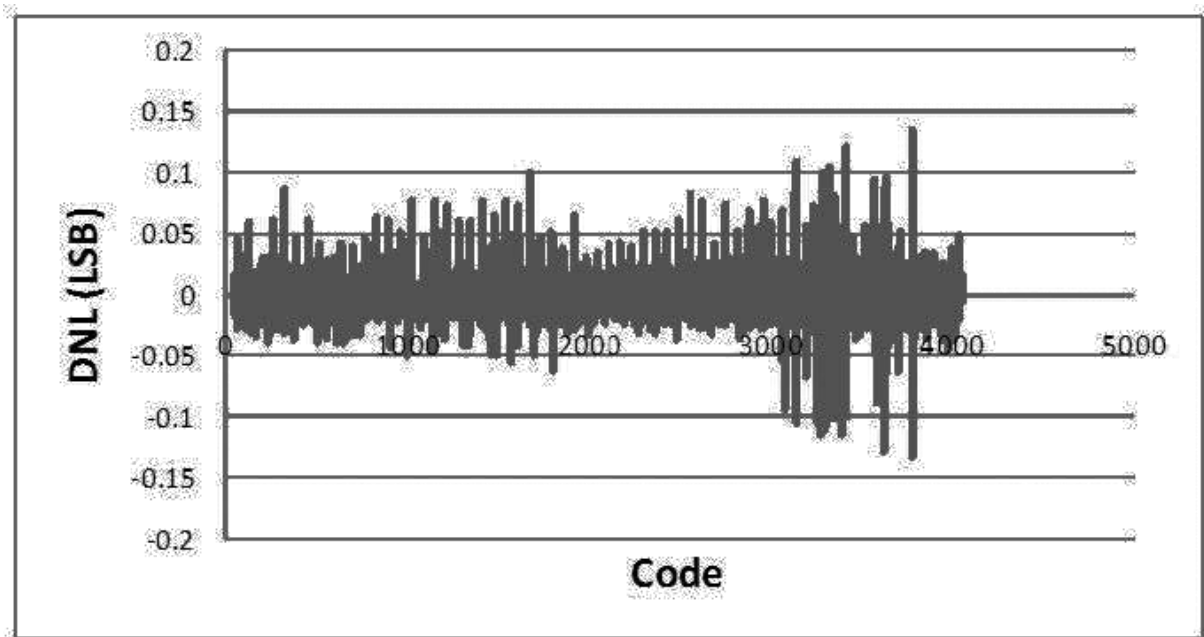


图 7. CBM128S085 典型 DNL

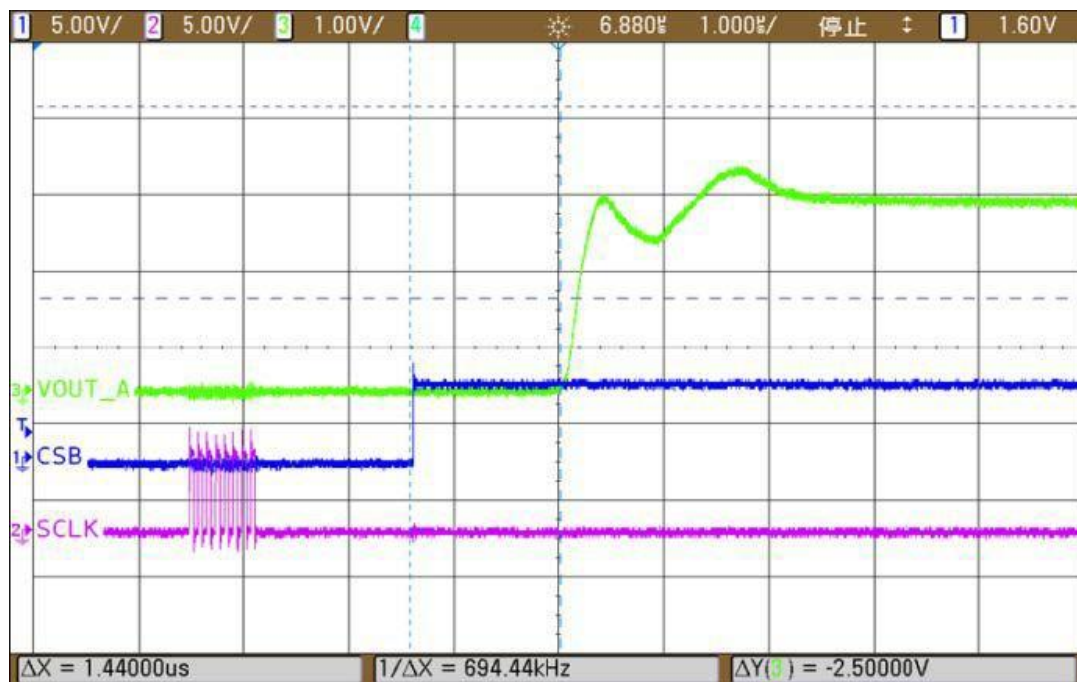


图 8. DAC 唤醒 (退出休眠状态) 过程

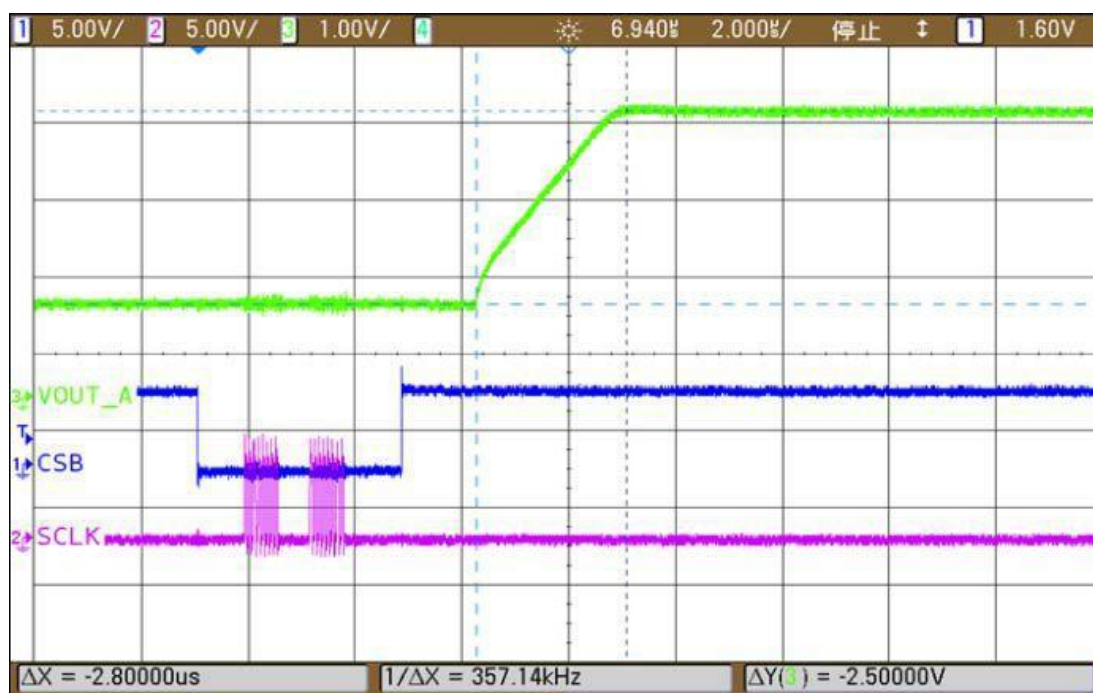


图 9. 输出建立过程 (0.25 满幅至 0.75 满幅变化)

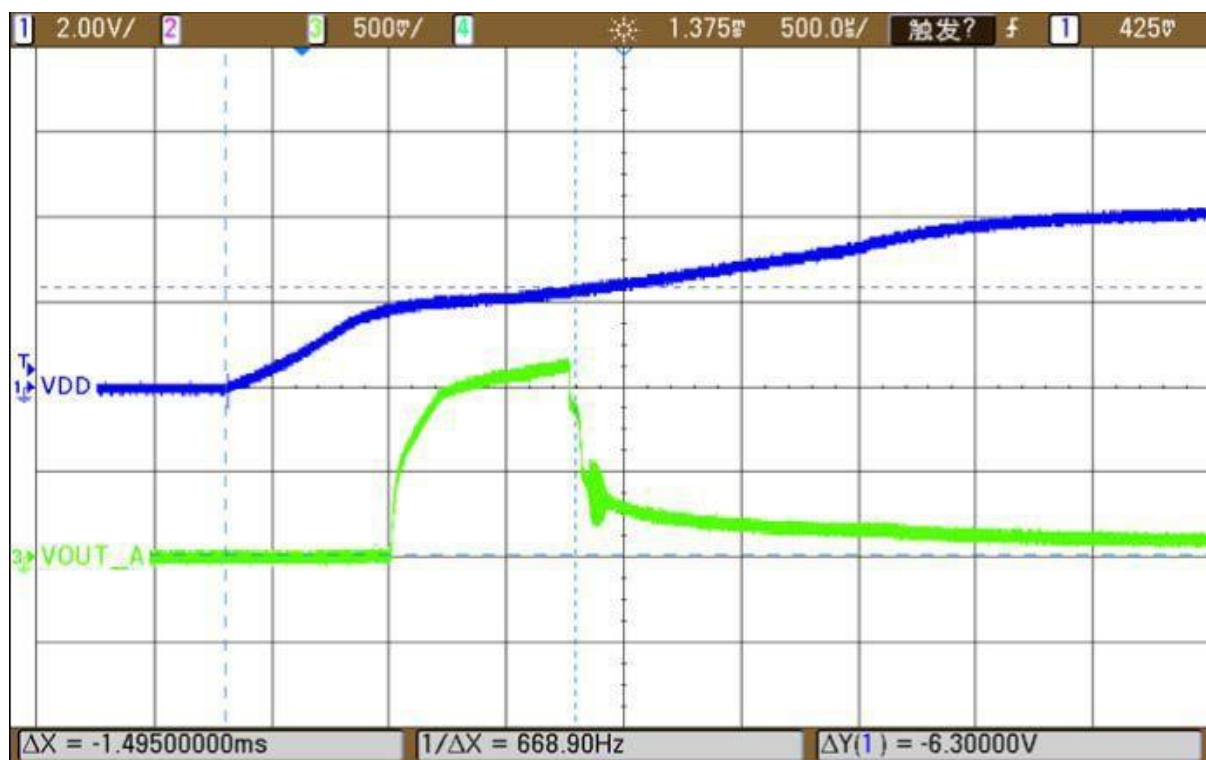


图 10. 上电复位

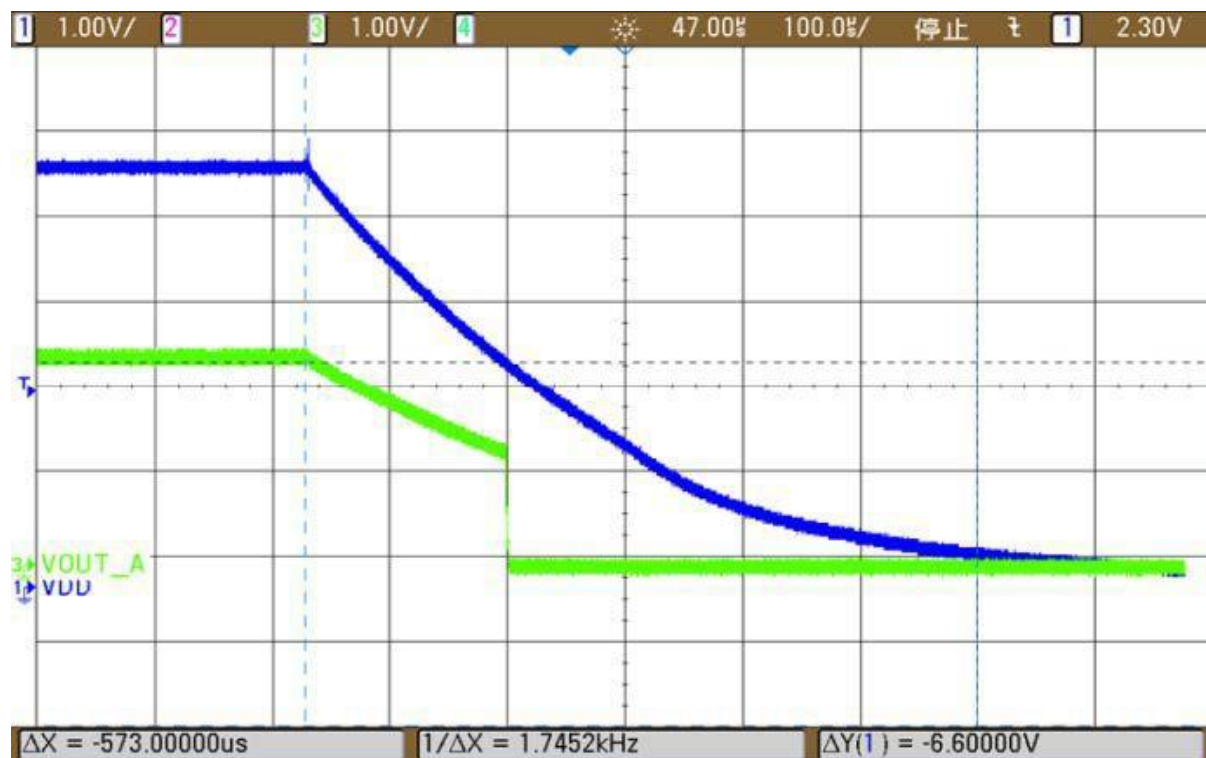


图 11. 断电复位

功能说明

DAC 结构

CBM128S085/CBM108S085 中含有 8 通道 DAC，每个通道都包含一 DAC 寄存器、一个电阻串结构 DAC 和一输出驱动电路。电阻串结构 DAC 通过电阻串分压产生对应的电平，然后开关选择相应输出。为了驱动外部负载，每通道输出端都增加了一缓冲驱动电路。

电阻串 DAC 结构示意图如图 12 所示，电阻串由 N 个等值电阻组成，参考电压直接加在电阻串上，电阻分压产生 N 个输出电压，分别由 N 个开关控制，相邻电压均为 V_{LSB} 。每个电阻电压均可通过闭合对应开关输出，数字输入信号控制开关的闭合与断开，每个输入码对应一个开关，因此对于 10bit 精度， $N=1024$ ；对于 12bit 精度， $N=4096$ 。

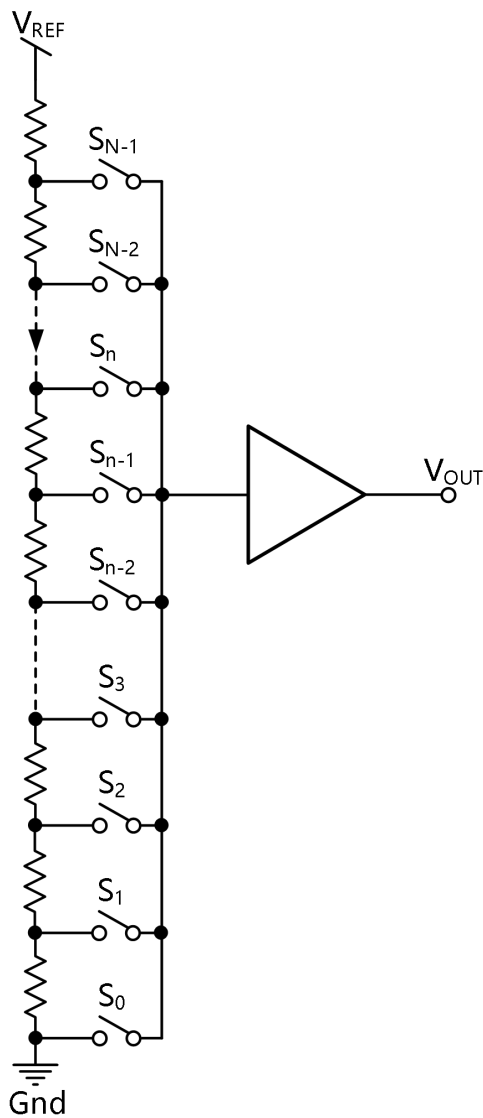


图 12. 电阻串 DAC 结构示意图

当输入数字信号为 D 时:

$$V_{OUT} = V_{REF} \times (D/N)$$

CBM128S085 时 N=4096; CBM108S085 时 N=1024。CBM128S085/CBM108S085 中的 8 通道 DAC, 其中 ABCD 通道采用 VREF1 参考电压, EFGH 通道采用 VREF2 参考电压, 参考电压直接从外部输入因而可以灵活设置。数字信号 D 由串行接口写入内部 DAC 寄存器, 进而控制 DAC 最终输出电压。CBM128S085/CBM108S085 的 8 通道 DAC 可以单独控制其使能或休眠, 休眠状态下 DAC 的输出有三种模式: 高阻、2.5K 欧姆阻抗到地和 100K 欧姆阻抗到地, 可以根据实际需要进行选择。

DAC 输出缓冲驱动电路采用轨到轨结构, 输出电压范围为[0,V_A] (实际输出电压范围受限于参考电压的大小), 当输出电压接近 0 或 V_A 时, 缓冲驱动电路的线性度会快速恶化, 因此线性度指标 INL 的定义中去掉了部分最大码和最小码, 在实际应用中应需注意。输出缓冲驱动电路可以驱动 2K 欧姆电阻负载以及 1500pF 到地或电源的电容。负载电阻减小时, 驱动电流相应增大, 导致输出电压会有所变化, 具体的结果请参考前面的特性说明。缓冲驱动电路内置输出短路保护装置, 保护电流典型值为 20mA。

串行接口

串行接口描述

输入端的三线串行接口与 SPITM, QSPI 和 MICROWIRE, 以及大多数的 DSP 接口兼容, 其时钟工作频率最高能达到 40MHz。芯片的写操作在时钟下降沿进行, 数据以 16 个周期为一帧, 即在一帧数据同步序列内有 16 个时钟下降沿, 详细接口时序如图 13 所示, 具体数值请参考表 4。

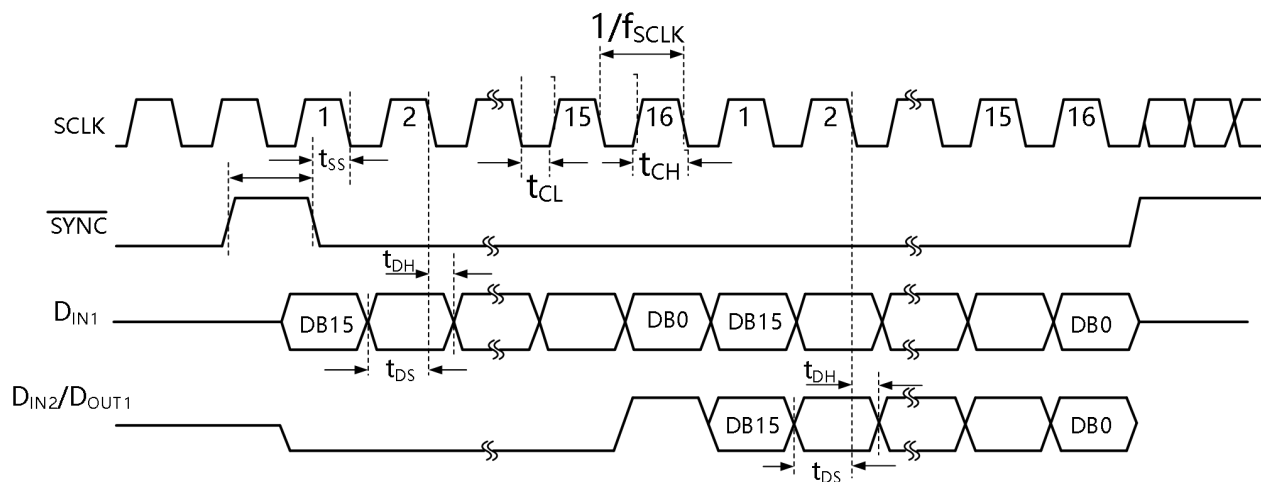


图 13. 串行接口时序

以写一帧数据为例, 当 SYNC 信号拉低, 芯片的写操作开始执行, 在 DIN 输入的数据通过 SCLK 的下降沿同步至移位寄存器。为了避免时钟错误, 需要保证 SYNC 下降沿与时钟下降沿之间的建立时间 (SYNC 与 SCLK 的时序关系)。当 SCLK 的第 16 个时钟下降沿到来, 最后一位数据写入移位寄存器。此时, SYNC 信号变高, 芯片开始进行编程操作 (通道选择, 模式选择与寄存器内容变更等)。SYNC 信号变高之后的时钟下降沿不会对芯片产生影响。

若 SYNC 在第 15 个时钟下降沿前变高, 移位寄存器中写序列操作数据将被视为无效。当时钟沿超过 17 个下降沿时, DIN 的数据将在 DOUT 端口上依次输出。这种操作模式的更多信息可参考菊花链工作模式。

当 DIN 为高时, 输入端驱动器需要消耗更多的电流, 在写序列有效时, DIN 应当处于闲置状态从而降低功耗。另一方面, 当处于菊花链模式 DOUT 有效输出时, 同步帧信号应处于空闲状态。

菊花链工作模式

菊花链 (Daisychain) 工作模式允许单个串行控制器同时对多个芯片进行操作, 进而减少信号线数目并且简化连接。菊花链工作模式下, 所有芯片共享 SYNC 和 SCLK 信号, 前一芯片的 DOUT 信号接后一芯片的 DIN。串行接口接收数据时仍然以帧为单位, 当数据长度超过一帧时, 芯片在接收当前帧的同时会把前一帧的数据依次从 DOUT 端口输出给后续芯片, 进而作为后续芯片的数据输入。当 SYNC 信号上升沿到来时, 所有芯片会把当前接收到的帧数据同时更新至串行输入寄存器。

以三颗芯片菊花链为例进行说明，此时连接如图 13 所示，DAC1 的 DOUT 输出给 DAC2 的 DIN，DAC2 的 DOUT 输出给 DAC3 的 DIN。串行控制器发送数据时的时序如图 15 所示，在 SYNC 信号为低时发送 3 帧数据，分别输出给 DAC3、DAC2 和 DAC1，注意数据发送顺序。需要特别注意的是 DOUT 是在 SCLK 信号下降沿更新的，将在 SCLK 信号的下一次下降沿被后续芯片采样，为了保证正确采样需要满足 DIN 信号保持时间的要求，因此需要特别注意板上 SYNC、SCLK、DIN 和 DOUT 信号的延时，必要时需要在 DIN 和 DOUT 中间加入延时。

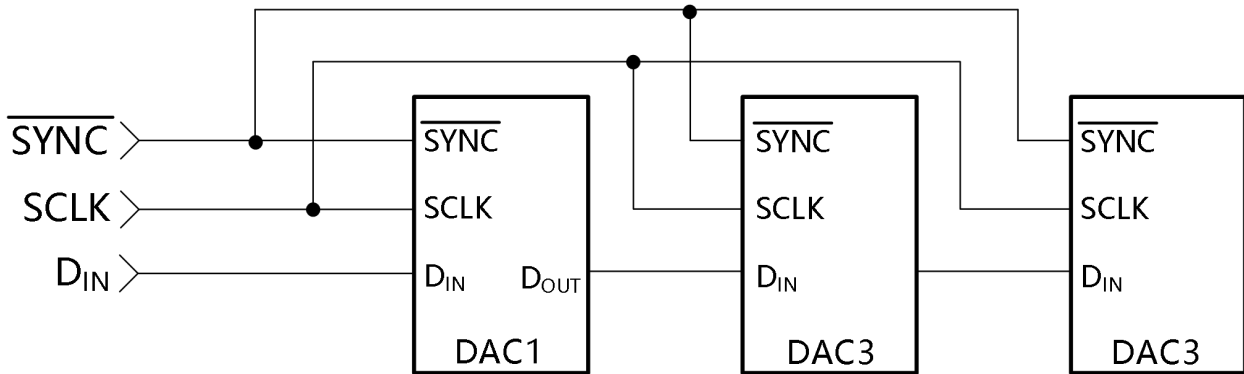


图 14.菊花链连接

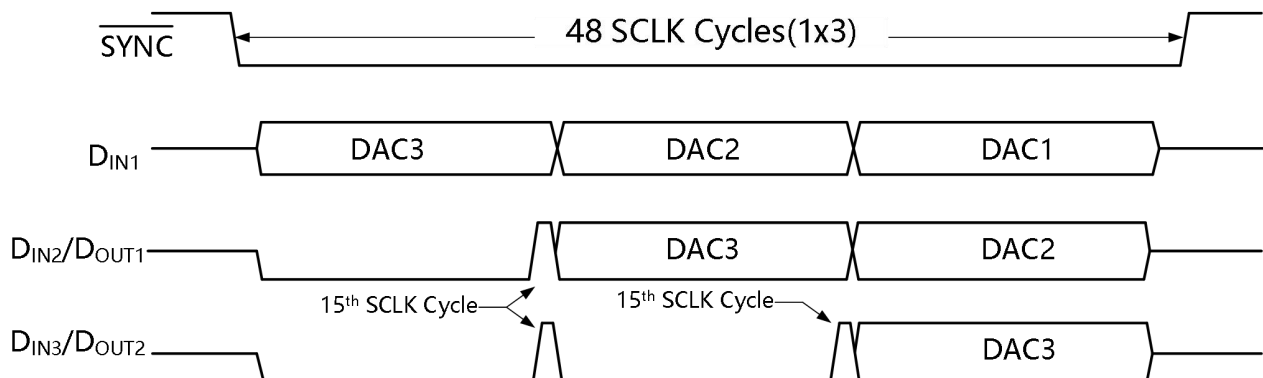


图 15.菊花链时序

串行输入寄存器

串行输入寄存器以 16 位为一帧，记为 DB[15:0]，其中前 4 位 DB[15:12] 为模式控制位，后 12 位 DB[11:0] 为数据位。串行输入寄存器的说明一览表如表 6 所示。CBM108S085 为 10bit DAC，因此当 D[15]=0 时，数据位 D[11:0] 中只有 D[11:2] 有效，剩余 D[1:0] 无效。D[11] 为 MSB，D[0] 为 LSB。DB[15:12]

把串行输入数据分为 4 种类型，分别是：写数据/DAC 寄存器、模式控制、特殊命令和休眠模式，分别对应不同的功能。

表 6 串行输入寄存器说明

类型	DB[15:12]	DB[11:0]	说明
休眠模式	1111	xxxx_HGFEDCBA	DB[7:0]相应位为'1'时, 对应通道进入休眠状态, 2.5K欧姆阻抗输出
	1110	xxxx_HGFEDCBA	DB[7:0]相应位为'1'时, 对应通道进入休眠状态, 100K欧姆阻抗输出
	1101	xxxx_HGFEDCBA	DB[7:0]相应位为'1'时, 对应通道进入休眠状态, 高阻输出
特殊命令	1100	D11 D10 ... D1 D0	广播模式: 所有通道的数据寄存器和 DAC 寄存器同时更新为 DB[11:0]的值。
	1011	D11 D10 ... D1 D0	A 通道更新: A 通道的数据寄存器和 DAC 寄存器同时更新为 DB[11:0], 其它 7 个通道的 DAC 寄存器也同时更新为对应数据寄存器的值。
	1010	xxxx_HGFEDCBA	更新选择: 当 DB[7:0]某位为'1'时, 对应通道 DAC 寄存器更新为数据寄存器的值, DAC 输出也随着更新。
模式控制	1001	xxxx_xxxx_xxxx	WTM 模式命令
	1000	xxxx_xxxx_xxxx	WRM 模式命令
写数据/DAC	0111	D11 D10 ... D1 D0	WRM: D[11:0]仅写入 H 通道数据寄存器
寄存器			WTM: D[11:0] 直接更新 H 通道 DAC 寄存器
	0110	D11 D10 ... D1 D0	WRM: D[11:0] 仅写入 G 通道数据寄存器 WTM: D[11:0] 直接更新 G 通道 DAC 寄存器
	0101	D11 D10 ... D1 D0	WRM: D[11:0] 仅写入 F 通道数据寄存器 WTM: D[11:0] 直接更新 F 通道 DAC 寄存器
	0100	D11 D10 ... D1 D0	WRM: D[11:0] 仅写入 E 通道数据寄存器 WTM: D[11:0] 直接更新 E 通道 DAC 寄存器
	0011	D11 D10 ... D1 D0	WRM: D[11:0] 仅写入 D 通道数据寄存器 WTM: D[11:0] 直接更新 D 通道 DAC 寄存器
	0010	D11 D10 ... D1 D0	WRM: D[11:0] 仅写入 C 通道数据寄存器 WTM: D[11:0] 直接更新 C 通道 DAC 寄存器
	0001	D11 D10 ... D1 D0	WRM: D[11:0] 仅写入 B 通道数据寄存器 WTM: D[11:0] 直接更新 B 通道 DAC 寄存器
	0000	D11 D10 ... D1 D0	WRM: D[11:0] 仅写入 A 通道数据寄存器 WTM: D[11:0] 直接更新 A 通道 DAC 寄存器

所有 DAC 通道都包含两个寄存器: 数据寄存器和 DAC 寄存器, 更新 DAC 寄存器会直接更新 DAC 的输出模拟信号; 数据寄存器暂存串行接口输入的数据, 用户可以发送命令把 DAC 寄存器更新为数据寄存器中的值。当所有数据寄存器都写入后, 用户可以发送命令控制所有 DAC 通道的输出同时更新。

串行接口控制寄存器的更新有两种方式：WRM (Write Register Mode)和 WTM (Write Through Mode)。写数据/DAC 寄存器时，WRM 方式下只有数据寄存器被更新，WTM 方式下数据寄存器和 DAC 寄存器同时更新。芯片上电默认采用的是 WRM 方式。

串行输入特殊命令有三个：更新选择、A 通道更新和广播模式。更新选择命令可以选择性的对某一通道进行 DAC 寄存器更新，进而更新 DAC 的输出；A 通道更新命令在写入 A 通道数据的同时更新所有通道的 DAC 输出；广播命令可以把所有通道的数据寄存器和 DAC 寄存器同时更新为同一值。

休眠模式

CBM128S085/CBM108S085 的 8 通道 DAC 均可以单独配置为休眠模式，休眠模式通过设置串行输入寄存器来完成，设置 DB[15:12]为所需的休眠模式，并把需要休眠的通道的对应位设置为“1”。当 8 通道 DAC 全部休眠后，芯片内部的偏置电路也一并休眠，不过芯片内部断电复位电路此时仍然在正常工作，消耗电流的典型值约为 10uA。

上电/断电复位

CBM128S085/CBM108S085 内部同时含有上电复位和断电复位电路，该复位电路同时控制所有通道的输出，复位后所有通道的数据/DAC 寄存器设置为全 0，DAC 的最终输出也为 0 电平。当电源电压升高至芯片最低工作电压后产生复位操作，波形如图 10 所示。断电复位发生在芯片电源断电过程中，当电源电压低于约 2.7V 时，产生复位操作，波形如图 11 所示。

封装尺寸及结构

TSSOP16

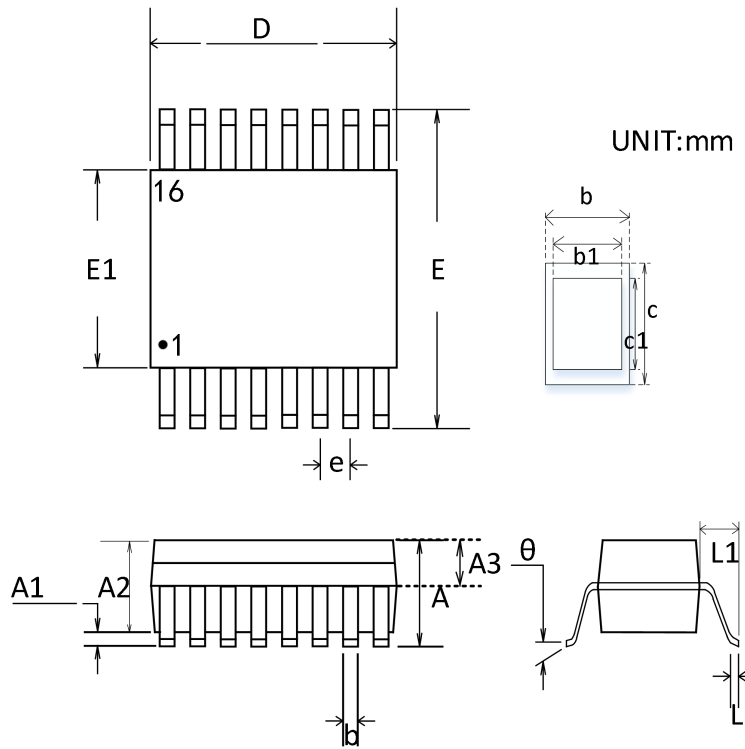


图 16. TSSOP16 封装尺寸图

符号	尺寸 (毫米)	
	最小值	最大值
A	--	1.20
A1	0.05	0.15
A2	0.90	1.05
A3	0.39	0.49
b	0.19	0.30
b1	0.19	0.25
c	0.13	0.19
c1	0.12	0.14
D	4.9	5.1
E	6.2	6.6

E1	4.3	4.5
e	0.65 BSC	
L	0.45	0.75
L1	1.00 BSC	
θ	0	8°

QFN16

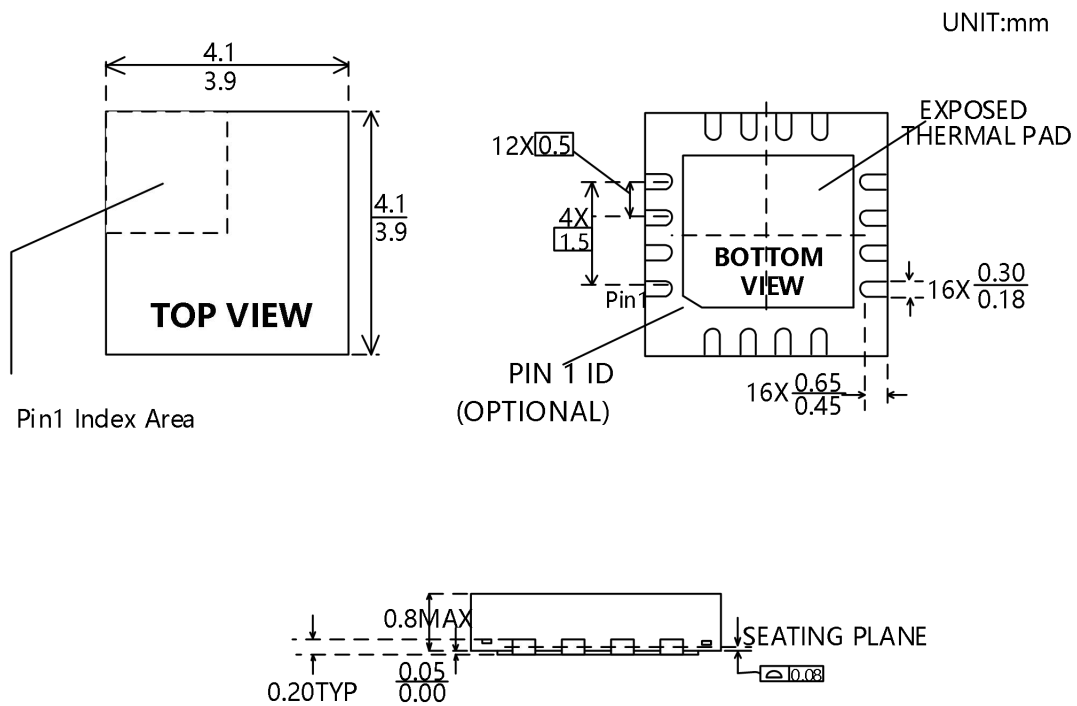


图 17. QFN-16 封装尺寸图

包装/订购信息

产品型号	温度范围	产品封装	丝印	包装数量
CBM108S085QS	-40°C~125°C	QFN16	08S5	编带和卷盘,每卷 2500
CBM108S085TS	-40°C~125°C	TSSOP16	CBM108S085T	编带和卷盘,每卷 2500
CBM108S085TS-RL	-40°C~125°C	TSSOP16	CBM108S085T	编带和卷盘,每卷 3000
CBM108S085TS-REEL	-40°C~125°C	TSSOP16	CBM108S085T	编带和卷盘,每卷 4000
CBM128S085QS	-40°C~125°C	QFN16	28S5	编带和卷盘,每卷 2500
CBM128S085TS	-40°C~125°C	TSSOP16	CBM128S085T	编带和卷盘,每卷 2500
CBM128S085TS-RL	-40°C~125°C	TSSOP16	CBM128S085T	编带和卷盘,每卷 3000
CBM128S085TS-REEL	-40°C~125°C	TSSOP16	CBM128S085T	编带和卷盘,每卷 4000